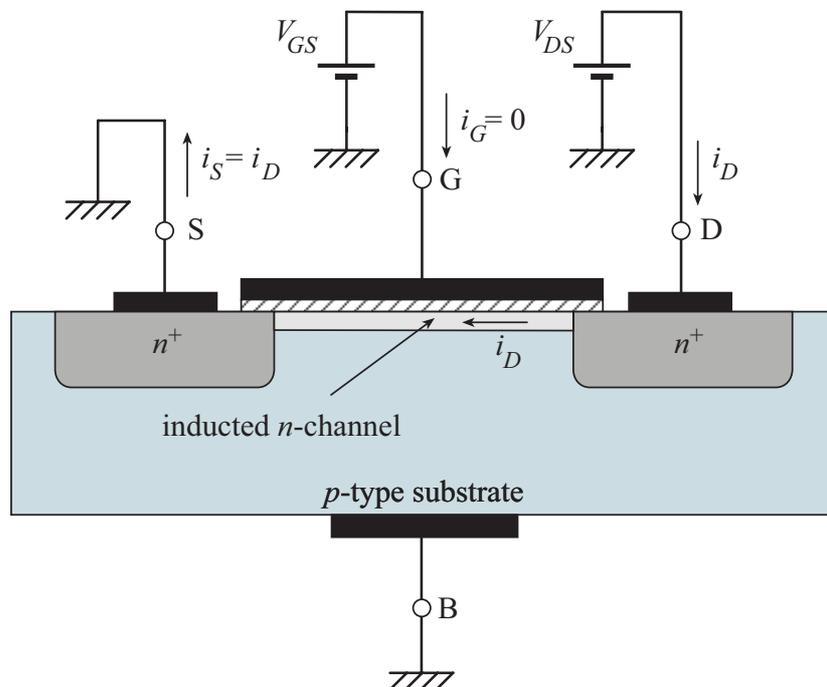


Transistor NMOS ad arricchimento con una tensione positiva applicata al gate. Un canale di tipo  $n$  è indotto sulla superficie della regione del substrato in corrispondenza del gate.



Transistor NMOS con  $V_{GS} > V_{TH}$  ed una debole  $V_{DS}$  applicata. Il dispositivo si comporta come una conduttanza il cui valore è determinato da  $V_{GS}$ . In particolare, la conduttanza del canale è proporzionale a  $V_{GS} - V_{TH}$  e la corrente  $I_D$  è proporzionale a  $(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$ , (per semplicità la regione di svuotamento non è mostrata).